加速器から発生する テラヘルツ波の利用

1. はじめに

一般に、3×10¹¹~3×10¹² Hz (0.3~3 THz, 10~ 100 cm⁻¹, 1.2~12 meV)の周波数を持つ電磁波を テラヘルツ (THz) と呼んでいる。この領域は, 高周波側(高エネルギー側)の光と低周波側(低 エネルギー側)の電波との境に位置しており、 光と電波のそれぞれの領域で開発されてきた光 源や検出器の技術の延長では難しい領域である ため,「テラヘルツギャップ」と呼ばれていた[1]。 (図1)しかしながら、格子振動や分子振動、半 導体のエネルギーギャップ,伝導キャリアのプ ラズマ振動数,電子格子相互作用や電子間相互 作用で生じる準粒子など,物質科学の根本に関 わる素励起の重要な情報を多く含んでいるた め、古くから熱光源(プランク輻射の原理を利 用)を用いて地道に基礎的な研究が展開されて いる[2]。この流れの延長上で, 1980年代半ばに, より先端的なテラヘルツ分光を目的として分子 科学研究所 UVSOR にシンクロトロン放射光 (SR)を用いたものとしては世界最初の共用ビー ムラインが建設された[3]。このビームラインの 成功が発端となり、世界各地に THz だけではな く更に高周波側(短波長側)の赤外(IR)領域 も含むビームラインの建設がされている。最近 の放射光施設には、必ずといっていいほど、 THz・IR ビームラインが設置・計画されている。

一般に、FTIR は、気体などの軽い分子からタ ンパク質などの重い分子の振動モードを精密に 測定することができるため, 医薬品や化学合成 部室などの分析に,大学や民間企業の研究機関 で広く用いられている[4]。それに対して、現在 のTHz・IR ビームラインの主な目的は、市販の 赤外分光計(FTIR)に内蔵されているグローバ ー灯や高圧水銀灯などに比較して桁違いに高い 輝度及び強度を利用した,回折限界空間分解能 での分光やイメージング, meV 領域 (sub-THz) の分光、および理想的な点光源であることを用 いた超分解能分子分光などである[5]。THz・IR ビームラインは, 市販の FTIR では到達できない 空間分解能およびエネルギー分解能を実現し, また測定可能な範囲を低波数側へ拡張すること に貢献してきた。このように、これまでの THz



図 1. THz 波(0.3~3 THz)のより高周波側(光)と低周波側(電波)の主な光源の強度分布。 (参考文献1より転載。)

放射光 (THz-SR), IR 放射光 (IR-SR) は検出光 としての利用であった。

その一方で,通常の放射光のような位相の揃 っていない光とは異なり、コヒーレントで大強 度という性質を持つ放射光発生の基礎研究が行 われてきた。THz・IR 領域では、コヒーレント な放射光は2種類ある。1つは、アンジュレー タ中で電子ビームと発生した光との相互作用に よって発生する単一周波数の電磁波で、自由電 子レーザー (FEL) と呼ばれているものであり, もう1つは、波長より短い電子ビームでは、電 子から発する放射光の電場が揃っていることを 用いたコヒーレント放射である。コヒーレント 放射は, 放射光利用者に馴染みの深い, シンク ロトロン放射 (CSR) やエッジ放射 (CER) · 遷 移放射(CTR)などがある。これらの光は、FEL と違って白色であるにもかかわらず、通常の放 射光に比べて、桁違いに高い強度を持つところ に特徴がある。

CSR の研究は, 1980 年代終わりの電子線ライ ナックからのコヒーレント放射光 (CSR) の観 測[6]から, 2000 年以降の電子蓄積リングでの CSR の生成と進化してきた。現在, CSR を利用 できる外国の主な施設としては, ドイツ BESSSY II [7], MLS [8], フランス Soleil Synchrotron [9], イギリス Diamond light

source [10]などがあり,国内では, UVSOR-III [11],京大原子炉ライナック [12]などである。

2002 年に, アメリカ Jefferson Lab.の エネルギー回収型ライナック(ERL) において, これまでにない大強度で自 色の CSR が観測された[13]。(図 2) こ のことが契機になって, その後, 英国 Daresbury の ERL 加速器 ALICE に THz ビームラインが建設され, 2009 年に最 初の THz-CSR が観測されている[14]。 KEK の cERL でも, 2000 年代前半から, cERL からの THz 光の発生と利用が計 画されてきており, 最近になって, CSR が実際に観測された。 本稿では、一般的に広く用いられている THz 光源を紹介し、その後、CSR の発生原理とこれ までに開発・研究されてきた CSR を説明する。 その後、cERL からの THz 光の期待される性能 と、それを利用するための光学系について示す。 最後に、THz FEL や CSR などの大強度 THz 光の 応用研究について概観する。

2. テラヘルツ光源の種類と性質

THz 光源は,その発光原理により,4 つの種類に分けられる。

1 つ目は、プランク輻射の原理を使った、い わゆる熱光源・黒体輻射光源と呼ばれるもので あり、グローバーランプ・セラミック光源や高 圧水銀灯がそれにあたる。物体は、熱すると電 磁波を発する。THz 領域は室温と同程度である ため、室温程度またはそれ以上の温度を持った 物質(例えば人体)からも、THz 波が出ている。 しかしながら、その強度の変化は室温のゆらぎ となるため、分光するのに十分な S/N は得られ にくい。そこで、室温のゆらぎより十分高い強 度が得られるように、物体を 1000℃以上の温度 に熱し、THz 光源とすることができる。この場 合、光源は極めて安定な連続の白色光源になる。 光源が安定しているため、分光器にラピッドス



(www.jlab.org/FEL/felscience.html より転載。)

キャン型フーリエ干渉分光計を用いて光に変調 をかけ、その光をシリコンボロメータで検出す るのが一般的な手法である。この方法は、光源 の輝度は低いが、取り込む立体角を大きくすれ ば反射・吸収測定に十分な強度が得られ、かつ、 極めて安定しているため、現在でも広く用いら れている。

2 つ目は、モード同期チタンサファイアレー ザーをベースとした光整流効果や光電導スイッ チを用いた手法であり、1990年代前半に出現し たものである[15]。パルスレーザーを使うため に,超高速時間分解測定も可能であり,従来の FTIR を用いた THz 分光では不可能であった励 起状態のダイナミクス測定も可能になった。ま た, 電気光学 (EO) サンプリングを用いること で、ボロメータのように液体ヘリウムを用いる 必要がなく、室温での検出も可能である。最近 では、ニオブ酸リチウム LiNbO3 結晶を用いて、 1 MV/cm の電場, 2 µJ のピークパワーを超える 白色のパルス電場が生成されている[16]。また, 量子カスケードレーザー[17]や THz 波パラメト リック発生や差周波 THz 波発生[18]を使うこと で、単色の THz 波が得られる。

3 つ目は,固体発信器であり,ガンダイオード,共鳴トンネルダイオードが該当する。

4 つ目は、本稿で述べる電子線加速器を用い た手法である。主なものとしては、通常の SR、 FEL および CSR があるが、それ以外にも後進波 管(BWO)やジャイロトロン[19]がある。

これらのうち,図1のTHzギャップを埋める ほどの大強度が得られているものとしては, LiNbO₃を使ったレーザー光源と,電子加速器を 使ったFEL,CSR およびジャイロトロンである。 ただし,これらの光源は,その性質が大きく違 っている。ジャイロトロンは大強度が得られる が単一波長であり,プラズマ加熱やセラミック 等の焼結,電子スピン共鳴などに有用であるが, spectroscopyには不向きである。一方で,FELも 単色であるが,波長可変であるため,エネルギ ー可変の励起光としての利用や spectroscopy も 行われている。LiNbO3 レーザー光源と CSR はも ともと白色光である。

cERL からは, FEL と CSR が利用できる可能 性がある。そこで,これらの光源の特徴を,以 下に示す。

FEL は、基本的にレーザーであり、位相の揃 った回折限界の単色パルス光源である。パルス 幅は、ミクロパルス幅が1 psec 程度、マクロパ ルス幅が1 usec 程度である。波長はアンジュレ ータギャップや電子ビームのエネルギーを変え ることでコントロールできる。加速器としては, 通常は小型の線形加速器を用いる。そのため, 光のパルス(マクロパルス)間隔は、常伝導線 形加速器を用いた場合に数 Hz, 超電導線形加速 器を用いた場合に数 MHz~100MHz 程度にな る。世界にある主な施設としては, IR の FEL は, 常伝導のものがフランス(CRIO-LCP)[20],オ ランダ (FELIX-DFFER) [21]などにあり, 超電 導のものがアメリカ (Jefferson Lab, 現在停止中) [22]やドイツ (FELBE-HZDR) [23]にある。これ らの機関では、利用研究も行われている。国内 では,常伝導のものが,東京理科大学・赤外自 由電子レーザーセンター[24],京都大学・エネル ギー理工学研究所[25],大阪大学・産業科学研究 所[26]にある。また, THz の FEL は, FELIX-DFFER, FELBE-HZDR, アメリカ UCSB [27], Jefferson Lab., 阪大産研で稼働している。 東京理科大にも設置されているが、発振には至 っていない。cERL でも、本田らを中心に THz の FEL を発振させる計画がある [28]。

FEL から得られる THz 波の強度は、例えば、 阪大産研の FEL を例にすると、ミクロパルスで 200 µJ、マクロパルスで 25 mJ であり、これから 見積もった電場の大きさは 20 MV/cm になる [29]。この大きさは、パルスレーザーで LiNbO₃ を用いた場合より桁違いに強い。

CSR は、電子ビームの進行方向の長さまたは 微細構造の長さより長波長で発生し、広い波長 範囲をもつ白色光源である。発散角や偏光性は 通常の SR と一致するが、強度は可干渉性をもつ 電子数の 2 乗に比例する。電子蓄積リング中の 電子ビームは、1 つのバンチあたり 10⁹~10¹⁰ 個 程度の電子を持つため、その電子全体が可干渉 性を持った場合(つまり、波長がバンチ長より 長い場合)は、強度が 10⁹~10¹⁰ 倍に拡大するこ とになる。バンチが微細構造を持つことでバン チ内の一部が可干渉性を持った場合にも、桁違 いに強い強度になる。この CSR は、cERL から は常に発生している[30]ものであり、利用価値が 高い。次章では、CSR の発生原理について説明 する。

3. CSR の発生原理とこれまでの CSR

加速器中の電子バンチ中の電子は、全くラン ダムであるので、そのような電子ビームから発 する通常の放射光は、電子ビーム電流(電子数) に比例した強度になる(つまり、光の強度は電 子ビームの蓄積量、すなわちビーム電流に比例 する)。しかしながら、波長が電子バンチの進行 方向の長さより長くなると、バンチ中の電子の 位相は揃っていることになり、あたかも1つの 大きな電荷とみなすことができる。その場合、 電子バンチが偏向電磁石等で曲げられた際に生 じる電場 E は、電子数に比例することになる。 放射強度(フォトン数)は E²に比例するため、 結果として、放射強度は電子数の2 乗に比例す ることになる。これが CSR の発生原理である。

具体的には,電子バンチに含まれる電子数を *N_e*,電子バンチの進行方向の形状を*S*(*z*),放射 光波長をλとしたとき,CSRの強度*P*(λ)は,次 式になる[31]。

 $P(\lambda) = P_0(N_e + N_e^2 F_e),$ $F_e = \left[\int \exp i\left(\frac{2\pi z}{\lambda}\right) S(z) dz\right]^2$ (1)

ここで、 P_0 は電子1個からの放射強度、 F_e は 電子バンチの形状のフーリエ変換で、形状因子 と呼ばれている。この式の意味は、電子バンチ の全幅に相当する波長以下になると、CSR の強 度は、電子バンチ内の電子数の1乗から2乗に 変化することである。ただし、S(z)は形状を表し ており、 F_e はそのフーリエ成分であるため、S(z) が微細構造を持っている場合には、CSR が現れ る ($N_e^2 F_e$ が効く)範囲が低波長に伸びることに なる。例えば、S(z)としてガウス関数を仮定した 場合の形状因子 F_e を計算すると、図3になる。 この図から、 F_e は波長 λ - σ から立ち上がり、波 長 λ -10 σ でほぼ1になることがわかる。つまり、 CSR が現れるためには、バンチ長より十分に波 長が長くなければならず、安定な CSR はバンチ 長の 10 倍以上の波長が必要となる。また、強度 が電子数の 2 乗に比例することは、1 乗に比例 する通常の SR に比べて、CSR の強度の方が電 子数に敏感であること、つまり不安定であるこ とを示している。つまり、CSR を安定に利用す るためには、SR に比べて、バンチ形状や光源の 電子数の安定性がさらに重要になる。

このような CSR は, 1980 年代前半に Daresbury の放射光源 SRS で最初の観測が報告され[32], その後, 1980 年代後半に東北大の電子線ライナ ックで観測され,その基本的な性質が詳細に研 究された[33]。また,CSR だけではなく,遷移 放射[34],チェレンコフ放射[35],スミス・パー セル放射[36],回折放射[37]など,多くのコヒー レント放射に関する研究が行われ,これらの発 生原理の基礎が確立した。



図 3. 形状因子のスペクトル。バンチ内の電子 分布はガウス分布を仮定した。

電子線ライナックを使った場合,電子バンチ の長さは THz の波長に比べて短いため、主にバ ンチ長より長い波長で CSR が観測される。この ように、電子バンチ内のすべての電子が CSR に 関わる程度長い波長では,光の強度は電子ビー ム電流値の2 乗に比例する。通常の電子線ライ ナックでの電子バンチ内の電子数は 10⁶ 個程度 なので, CSR は通常の SR に比べて 10⁶倍増強さ れ, 10¹² 個の電子数がある電子バンチからの通 常のSRに匹敵する強度になる。通常のSRでは, バンチ内の電子数は 10¹⁰ 個程度なので, 1 つの 電子バンチから発する CSR の強度は,通常の SR より 100 倍程度強いことになる。ただし、平均 強度は電子バンチの繰り返し周波数に比例(電 子線ライナックは数 Hz, SR は 100 MHz 程度) するため、結果として、電子線ライナックから の CSR の平均強度は SR に比べて約 10⁻⁶ 倍に弱 くなる。このように、利用する場合に強度のメ リットはなかったため、当時は利用目的ではあ まり注目はされなかった。

その後, 2000 年あたりから, 通常の SR リン グからの CSR の研究とその利用が開始された。 通常の SR リングでは、電子ビームを安定に周回 させるために、電子ビームの進行方向の長さを 数 cm~数 10cm に伸ばしている。この電子ビー ム全体からの CSR は、その長さに対応する波長 より長波長で観測されるはずであり、それは THz 波より波長の長いマイクロ波の領域にな る。しかしながら,電子ビームそれ自体の不安 定性 (bursting) [38]や外部からパルス光を導入 して電子ビーム内に微細構造を作る方法(laser slicing) [39]や、電子バンチ内の構造の長さを THz の波長程度まで短くする運転 (low-αモー ド) [40]を行うなどして, THz 波の領域の CSR を作り出す方法が開発された。これらの方法で は,通常の SR を使う際のような電子バンチ全体 を使った(10¹⁰個の電子による) CSR とはいか ないまでも, 電子バンチ内の一部, または, low-α モードでは、通常の運転より数桁少ない数の電 子が CSR 発生に寄与するとしても、桁違いに大 きな増強が得られる。これら,通常の SR リング

で CSR を発生させる方法は,特殊な運転モード が必要であり,SR リングの主要な業務であるユ ーザー運転と同時並行では利用できていない。 そのため,CSR 専用のマシンタイムを確保する 必要があり,利用実験はあまり進んでいない。 そのような中でも,BESSY II では,超伝導体の THz 分光などの応用研究が行われている[41]。ま た,UVSOR-III では,ユーザー運転でレーザー スライスでの CSR 発生も検討している。しかし ながら,更に大強度の THz を常に使うことがで きる光源として,cERL の実用化に期待したいと ころである。

4. cERL からの CSR

cERL の運転パラメータを,以下に示す[42]。

- 1. 加速エネルギー: 20 MeV, 目標 35 MeV
- 2. 偏向電磁石の軌道半径:1m
- 3. 取り込み可能な立体角:発光点から 820 mm のところに 50 mm 角
- バンチ内電子数:最近の典型的な運転 0.5 pC/bunch,目標 7.7 pC/bunch
- 5. バンチ長:典型的な運転 2 ps RMS, 目標 50 fs RMS
- 6. RF 周波数: 162.5 MHz または 1.3 GHz

この運転パラメータを元にして、以下のよう にパラメータを設定し、予想される SR および CSR の強度分布スペクトルを導出した。

- a. 加速エネルギー:20 MeV
- b. バンチあたりの電荷・電子数:1 pC/bunch ~ 10⁷ 個/bunch
- c. ビーム電流: 0.16 mA @ 162.5 MHz ~ 1.3 mA @ 1.3 GHz
- d. バンチ長:現在 σ=0.6 mm @ 2 ps RMS, 目 標 σ=0.015 mm @ 50 fs RMS
- e. 取込角: 60×60 mrad²



図 4. cERL のパラメータから予想される SR と CSR の光子数スペクトル。ただし、バンチ内電荷 量 1 pC/bunch を仮定している。ここで CSR の計算には図 3 の構造因子を用いた。また、比較のた めに、UVSOR-III BL6B 赤外・THz ビームラインのフラックスも載せた。図 2 と横軸の単位が異な っているが、10⁻³ eV が 8 cm⁻¹に相当する。

このパラメータを用いて計算した, cERL から の SR および CSR のフォトンフラックスを光エ ネルギーの関数でプロットしたものを図4に示 す。SR の計算には SPECTRA ver.9.0 を用いた。 実線が SR のスペクトル分布であり,バンチ内の 電荷量を1pCに固定しており、すべてのパケッ トに電子バンチがいるので, フラックスは RF 周波数に比例する。破線及び点線は、CSR のス ペクトル分布である。ここでは、図3のように バンチ長がガウス分布していると仮定した。2 ps RMS の場合, σは 0.6 mm なので, 波長 0.6 mm (フォトンエネルギー:~2 meV) より長い(低 い)領域でCSR が現れる。また、目標値である 50 fs RMS の CSR は, oは 0.015 mm なので, 波 長 0.015 mm (フォトンエネルギー:~82 meV) より長い(低い)領域で現れる。これらどちら も, バンチ内の電荷量は 1 pC (電子数は約 10⁷ 個)なので、SRに比較してCSRの増大係数は、 10⁷倍になる。また、目標値の7.7 pCの電荷量の時は、約60倍増強され、光の最大強度は、約 10 W/cm⁻¹に達すると予想される。ただし、この 増大に達する(つまり、形状因子が1になる) のは、バンチ長の約10倍の波長以上(立ち上が りのエネルギーの約1/10以下)である。

また、軌道面上下方向の CSR の放射角は、通 常の SR と等しい。SR は、電子が光速に近い速 度で外場を受けながら運動する場合に、電子の 作る電磁ポテンシャル (Liénard-Wiechert ポテン シャル)によって発生する。その単位発散角あ たりの放射スペクトル強度の角度分布 $\frac{d^2P(\omega,\theta)}{d\omega d\Omega}$ は、

$$\frac{d^{2}P(\omega,\theta)}{d\omega d\Omega} = \frac{e^{2}}{12\pi^{3}\varepsilon_{0}c} \left(\frac{\omega\rho}{c}\right)^{2} \left(\frac{1}{\gamma^{2}} + \theta^{2}\right)^{2} \times \left\{K_{\frac{2}{3}}^{2}(\xi) + \frac{\theta^{2}}{1/\gamma^{2} + \theta^{2}}K_{\frac{1}{3}}^{2}(\xi)\right\}$$
(2)

で与えられる[43]。ここでeは素電荷, ϵ_0 は真空 の誘電率,cは光速, ρ は電子軌道の半径, γ は電 子の静止エネルギーに対する加速された電子の 比エネルギー, θ は放射方向からの角度, $K_{2/3}(\xi), K_{1/3}(\xi)$ は変形ベッセル関数であり,

$$K_{\frac{2}{3}}(\xi) = \sqrt{3} \int_{0}^{\infty} x \sin\left[\frac{3}{2}\xi\left(x + \frac{1}{3}x^{3}\right)\right] dx,$$

$$K_{\frac{1}{3}}(\xi) = \sqrt{3} \int_{0}^{\infty} \cos\left[\frac{3}{2}\xi\left(x + \frac{1}{3}x^{3}\right)\right] dx \qquad (3)$$

となる。また,

$$\xi = \frac{\omega\rho}{3c} \left(\frac{1}{\gamma^2} + \theta^2\right)^{3/2}$$

である。この式からわかることは、加速エネル ギーが大きい場合、つまり 1/γが小さい場合は、 放射強度はθの小さいところに集まる(発散角が 小さい)ことである。また、放射光の光源は加 速器中の電子ビームそのものであるため、大き さ(断面積)は1 mm²程度以下である。この小 さい光源と小さな発散角によって、理想的には 極めて低いエミッタンスをもつ光源になってい る。

cERL のパラメータから計算した,フォトンエ ネルギー1 meV (波長 1.2 mm) と 10 meV (0.12 mm) での SR の放射角を図 5 に示す。この図か ら,エネルギー10 meV の光は $\theta_y = 0$ mrad の軌道 面上から 30 mrad 程度以内に集まっているが,1 meV の光は,軌道面上 ($\theta_y = 0$ mrad) の強度に 比べて,そこから 40 mrad 程度離れた角度にピ ークがあり,強度は 80 mrad 程度まで広がって いる。偏向部のビームダクトの形状により,取 り込み可能な立体角は,縦方向が 60 mrad (±30 mrad) なので,10 meV の THz 波はほぼ取り出



図 5. cERL からの THz SR 光の軌道面外角度分布 の光エネルギー(波長)依存性。

すことはできても、1 meV の THz 波は、半分以 下になってしまう。この点を克服するためには、 偏向部のビームダクトを改良して、開口を更に 広げて取込角を増やすのが理想ではある。ただ し、そのことによって、電子ビームへ影響が出 ないことを担保しなければならない。一方で、 ビームダクトは金属製のために、THz 波の反射 率は高いことを利用して、ビームダクトを(定 在波を立てない)導波管として使うことも考え られる。その場合は、1 つの偏向部からの CSR だけではなく、上流の偏向部からの放射も利用 できるため、さらに大きな強度を得ることがで きる可能性がある。(ただし、下流の光学系は検 討が必要。)

5. IR/THz SR/CSR の光学系

ここでは、偏向部から放射される CSR の光学 系について述べる。CSR の放射角は通常の SR と同じものであるため、原理的には SR の光学系 がそのまま使用できる。

現在,赤外・THz SR を集光するために主に使 用されている鏡の形状は,大きく分けて 2 種類 ある。1つは,SR の発光する部分を"点"として 近似し,点光源からの集光鏡である球面鏡・楕 円面鏡・放物面鏡等を用いた光学系であり,も う1つは,SRの発光を"線"として取り扱う場合 で,3次元マジックミラーを用いたものである。 前者は,光を取り込む水平方向の立体角があま り大きくない時,後者は大きな取込角で強度を 稼ぎたいときに用いる。大きな取込角の場合に, 小さな球面鏡を複数配置して1つの焦点へ結像 させる方法を行っているところもある[44]。

cERLでは、現在のところ、偏向部の真空ダクトの形状により、大きな 60×60 mrad²の立体角を 取り込むことが可能であるため、3次元マジッ クミラーが最も理想的な集光光学系になる。そ こで、以下に 3次元マジックミラーをつかった 光学系の例として、筆者らがこれまで建設して きた UVSOR-III BL6B 赤外・THz ビームライン の概要を示す。

5.1. 3 次元マジックミラー

軌道面縦方向の水平方向の微小な電子軌道からの発散角は,式(2)で与えられるものになるが, 偏向電磁石からの放射の場合,磁場によって電子が受けたローレンツ力が作る円軌道が重要になる。縦方向と同様に,大きな発散角で SR を取り込もうとすると,発光点は電子の円軌道になる。このことは,偏向電磁石からの SR は,理想的な「点光源」ではなく「線光源」であることを意味する。この光を,球面鏡やトロイダル鏡などの点光源で理想的な光学系を用いると,その「集光点」も「集光線」になってしまい,SR の高い輝度を損ねてしまう。

そこで,非球面・非対称の集光鏡である「マ ジックミラー」が 1976 年に考案された[45]。こ の鏡の形状は,この鏡は円弧から接線方向に発 する SRを1点に集光するという近似が入らない 理想的な鏡の形状を持っている。その基本的な 考え方を図6に示す。円軌道上のE1とE2の2 点から接線方向に発するSRがマジックミラー 上で反射されて焦点Fに集光するものとする。 この時,E1から発したSRがFに到達するまで の時間と,電子ビームがE1からE2まで円軌道 上を移動し,その後E2からSRが放射されてF



図 6. マジックミラーの基本的な考え方。

まで到達する合計の時間が一致するものと考 え、鏡の曲面を定式化したものがマジックミラ ーである。この様にすると、E1から E2までの 間で1つの電子ビームから放射された SR を F に集光でき、また E1と E2の間の時間の遅れを 保障する事ができる。つまり、電子ビームのも つ時間構造を保存することができる。

このようなマジックミラーは理想的である が、定式化された 1970 年代当時は、まだ制作す る技術がなかったため、実証には至らなかった。 また、電子の運動する軌道面内だけ定式化(つ まり、軌道面に対して鉛直方向の形状がない 2 次元の関数)されており、上で説明した軌道面 に垂直な方向に発散した光の集光に関しては、 全く議論されていなかった。そのために、これ までに実際の放射光の集光に用いられることは これまで全くなかった。

偏向電磁石からの SR を集光するのには, 図 5 に示したように, SR は軌道面の外にも強度があ り,実際の光学系では,それを取り込む必要が ある。例えば UVSOR-III のパラメータを使って 軌道面外の強度を見積もったのが図 7a であり, 軌道面外の成分がかなりの割合を占める。そこ で我々は,このマジックミラーを軌道面に垂直 方向も集光するように拡張した形状(三次元マ ジックミラー,図 7c)を考案し,図 7b のような 集光を試みた。具体的には,水平方向はマジッ クミラーの形状,垂直方向は発光点と集光点, およびミラーの位置と入射角から決まる集光条



図 7. (a) UVSOR の偏向部からの SR 光の軌道面に垂直方向の光強度分布の光エネルギー依存性. UVSOR のパラメータで計算した。(b) 理想的な偏向電磁石光源の集光。(c) マジックミラーの形状の概念図。

件から出した球面の形状とした。具体的な式は、 参考文献46を参考にしていただきたい。

この光学系は,最初に 1999 年に SPring-8 の赤 外物性ビームライン (BL43IR) に導入した[47]。 その理由は,極めて大きな放射光リングである SPring-8 は偏向電磁石内の電子の軌道半径は約 40 m あり,水平方向の取込角を 36 mrad とした 場合には,約 1.44 m の円弧からの発光になり, 点光源とみなすことは困難なためである。

近赤外から遠赤外までカバーした広いエネル ギー領域の分光を行うには、比較的小さいシン クロトロン光源の方が有利である。そこで、三 次元マジックミラーを、SPring-8 より小さい光 源である UVSOR に導入した[48]。UVSOR には、 世界で最初に共同利用のために建設された赤 外・遠赤外ビームラインがあり、それを改造す る事になった際に、三次元マジックミラーを導 入して世界でも最も大きな取り込み角(215×90 mrad²)を実現した。この赤外・遠赤外ビームライン(BL6B)は順次更新・拡張され,現在では,回折限界の赤外イメージングと遠赤外顕微分光に利用されている。

5.2. UVSOR-III 赤外・THz ビームライン (BL6B)

BL6B の全体の写真および出射部の光学系を, 図 8a, 8b に示す。放射光を取り出す最初のミラ ーがマジックミラーである。ここで導入された 三次元マジックミラーの大きさは水平方向 300 mm, 垂直方向 100 mm で, 215 mrad (水平方向) × 90 mrad (垂直方向)の取込角を実現している。

このようにして取り出された放射光は,図8b で示されたように,2枚の平面鏡(M1,M2)で 光軸の位置及び方向を調整されて第一焦点

2 - 9



図 8. (a) UVSOR の赤外・遠赤外ビームライン BL6B の全体図. (b) SR 光を取り出す出射部。

(image focus) 位置に導かれる。図9に, BL6B の第一焦点での光の大きさを光線追跡法で計算 した結果と,実際に測定して得られた大きさを 示す。計算は0.1 eVの光に対して行い,半幅(σ) が1 mm (水平方向) × 2 mm (垂直方向)の大きさ になっている。これに対し,HgCdTe (MCT)検出 器を用いて 0.05~1 eV の範囲の光を観測した結 果,半径約 1.2 mm の円形であることがわかっ た。この結果は,3 次元マジックミラーによっ てほぼ理想的に放射光が集光されていることを 示している。また,第一焦点はマジック ミラーへの水平方向の見込み角($2\sigma_x$ ')は約 86 mrad なので、0.1eV の光に対する横方向の光の エミッタンス($\sigma_x \times \sigma_x$ ')は52 µm rad になる。一方 で、縦方向は、図 7a の発散角(σ_y '~12 mrad)と発 光点の中心からマジックミラーの距離(約 1 m) とマジックミラーから第一焦点までの距離(約 2.5 m)を考慮することにより、光のエミッタンス ($\sigma_y \times \sigma_y$ ')は5.4 µm rad となる。通常使われている 赤外分光計の光源のエミッタンスは $\sigma_{x,y} \times \sigma_{x,y}$ ' = 200~1000 µm rad 程度であり、放射光が極めて 低いエミッタンスを持つ光であることがわか る。



図 9. BL6B の焦点(図 8b の image focus)における ray trace によるビームサイズの計算値(a)と実際 の測定値(b)。計算は 0.1eV のエネルギーを仮定し,測定は, 0.05~0.5eV を積分した結果である。

このような低いエミッタンス性は高い輝度の 光を作る。実際に,BL6Bの輝度は,従来の光源 に比べて桁違いに高い。具体的には,中赤外域 (0.1~1 eV)付近では1~2桁程度高いだけだが, 遠赤外・遠赤外領域(0.1 eV以下)では2~4桁 高い。この性能は,微小領域に集光する必要が ある顕微分光に有利である。

図 8a には,現在のビームラインの各実験装置 (エンドステーション)の配置図も示してある。 エンドステーションは,顕微赤外分光イメージ ング,顕微 THz 分光,赤外・THz 反射吸収分光 の合計 3 つの装置がある。

6. 大強度 THz の応用

THz 波は、図 10 に示すように、様々な分野への応用が期待されている。それらのほとんどが、 非破壊検査やイメージングなどのプローブ光と しての利用である。これらの利用法は、検査試 料のある場所に観測装置を持ち込み、その場で 検査することが求められる場合が多いと思われ るが、さらに精密な分光測定やイメージングを 行う必要があるときには、大強度を利用できる CSR や FEL が利用されることになるであろう。

それ以外にも、CSR やFEL では、これまでに ない大強度やコヒーレンス性が使用できるとし たら、既存の方法からの延長ではなく、全く新 しい計測法が可能になる。例えば、CSR の特性 は、大強度なパルス特性および高いコヒーレン ス性を持った白色光としての特性である。例え ば、cERL からは、波数1 cm⁻¹ あたりの平均強度 は10 W、ピーク強度は1 MW(CSR の全強度を 1 mm²に集めると、ピーク強度は10 GW/cm²に 達する)が得られると予想できる。

この大強度な THz 波は,既存光源のテラヘル ツギャップを埋める光源であるため,これまで に THz 領域で進められてきた分光研究とは全く 違った研究が推進できる可能性がある。例えば, THz 光を用いたイメージングでは,現在可能な cm²程度の面積のイメージング測定を m²程度ま で一度に測定可能にする大面積イメージング や,強度のみをマッピングするのではなく,波 長を分解した測定,つまりカラー撮影が可能に なる。THz は分子の微細な振動が現れるいわゆ る指紋領域であり,波長を分解した測定を行う ことによって,分子の結合に関するわずかな違 いを読み取ることができ,それを空間イメージ ングすることで,たとえば細胞の癌化の情報が 得られるものと期待できる。

一方で大強度の THz 波は,近接場分光にも応 用できる。近接場分光は波長以下の開口を開け たプローブからでた光を試料にあてることで波 長以下の空間分解能で電子状態や分子結合など の情報を得る方法である。試料に照射される光 の強度は開口の大きさによるため,開口を小さ くして空間分解能を上げようとすると,大強度 光源が必要である。THz-CSR や FEL は従来の光 源に比べて 10⁶ 倍程度強いため,1 µm 以下の開 口でも十分な強度が得られるものと期待でき る。この空間分解能を用いると,細胞内や脂質 膜内の分子結合の変化を観測できることが期待 できる。つまり,生体物質の機能性の発現機構 を明確にすることが期待できる。

THz-CSR はパルス光であり、そのピーク強度 は 10 GW/cm²に達する。この強度は、既存のパ ルスレーザーによる THz 光源を遙かにしのぐも



図 10. テラヘルツ技術の広がり。(テラヘルツテ クノロジーフォーラムホームページ [www.terahertzjapan.com/frontier.html]より転載。)

のである。そのような大強度の THz 光は,励起 光としての利用が可能である。例えば, THz 領 域は分子の指紋領域であることから,その分子 振動を選択的に励起することによって化学反応 を制御できる可能性がある。特に,半導体中の 不純物は,半導体の機能性の起源であるが,そ の固有のモードを共鳴励起することで,選択的 に拡散させることができる。このことは,熱に よる拡散に比べてより理想的な電子状態・機能 性を作り出すことが可能になる。

また、cERL の特徴として、THz-CSR とレー ザーコンプトン X 線の両方を利用することで、 THz 励起の X 線回折という実験も期待できる。 THz 光は格子振動を直接励起できることを利用 し、物質にコヒーレントフォノンを誘起し、そ の際に発生する格子変形および相転移を時間分 解 X 線回折で観測するというものであり、物性 物理の新たな展開が期待できる。

このような大強度 THz 光は,電磁環境両立性 (Electromagnetic Compatibility, EMC)の研究にも 重要である。昨今,電波利用が急激に発展し, 日常生活で不可欠のものになっている。電波の 利用で便利になる一方,人体や電子機器への影 響を調べることが重要になっている。今後携帯 電話などで大量の情報をやりとりする必要が出 てくることが予想されるが,その際には,現在 の周波数より高い THz 領域の電磁波を使うこと になるであろう。その際の EMC を調べる上で, cERL からの大強度 THz 波は重要な役目を果た すことが期待できる。

これまで上げたもの以外にも THz 波の応用は 数 多 く あ る 。 例 え ば , 2004 年 の 米 国 DOE-NSF-NIH の THz ワークショップの報告書 が有益である[49]。興味があれば,参照いただき たい。

7. まとめ

本稿では、赤外・THz SR の概要と、cERL で 期待される大強度 THz CSR の発生原理、cERL で予想される THz 波の性能、今後作る予定のビ ームラインの考え方の例として、UVSOR-III の 赤外・THz ビームラインの光学系について紹介 した。また, cERL や FEL の大強度 THz を使っ て今後進めるべき想定される課題について,述 べた。cERL に THz ビームラインができた際に は,これまでに類を見ないほどの大強度白色 THz 波が利用可能になり,新しい研究や分析が 可能になるものと思われる。

本稿がきっかけになって,まったく新しい THz 分光法・分析法が生まれればと考えている。 今後の cERL の発展に期待したい。

謝辞

本稿をまとめるにあたり、ご推薦いただいた 河田教授, cERL のパラメータを教えていただい た本田洋介博士, FEL とレーザーTHz のご議論 いただいた入澤明典博士, 渡邊浩博士には心よ り感謝いたします。

- [1] M. Tonouchi, Nature Photonics 1, 97 (2007).
- [2] S. S. Mitra and S. Nudelman (eds.),
- [2] S. S. Mitra and S. Nudelman (eds.),

"Far-Infrared Properties of Solids", (Plenum Press, 1970).

[3] T. Nanba, Y. Urashima, M. Ikezawa, M.

Watanabe, E. Nakamura, K. Fukui, and H. Inokuchi, Int. J. Infrared Millimeter Waves **7**, 1769 (1986)

- [4] 例えば,西岡利勝編,「高分子分析入門」(講 談社,2010).
- [5] Ex.) S. Kimura (ed.), WIRMS 2007 proceedings, Infrared Phys. Tech. 51 (2008).
- [6] T. Nakazato, M. Oyamada, N. Niimura, S. Urasawa, O. Konno, A. Kagaya, R. Kato, T. Kamiyama, Y. Torizuka, T. Nanba, Y. Kondo, Y. Shibata, K. Ishi, T. Ohsaka, and M. Ikezawa, Phys. Rev. Lett. 63, 1245 (1989).
- [7]www.helmholtz-berlin.de/pubbin/igama_output? modus=einzel&sprache=en&gid=1691&typoid=3 7587
- [8] www.ptb.de/mls/

- [9] www.synchrotron-soleil.fr/Recherche/ LignesLumiere/AILES
- [10] www.diamond.ac.uk/Beamlines/ Soft-Condensed-Matter/B22.html
- [11] www.uvsor.ims.ac.jp/
- [12] www.rri.kyoto-u.ac.jp/LINAC/
- [13] G. L. Carr, M. C. Martin, W. R. McKinney, K. Jordan, G. R. Neil, and G. P. Williams., Nature 420, 153 (2002).
- [14] www.stfc.ac.uk/about-us/where-we-work/alice/
- [15] テラヘルツテクノロジーフォーラム編,「テ ラヘルツ技術総覧」(NGT, 2007).
- [16] H. Hirori, A. Doi, F. Blanchard, and K. Tanaka, Appl. Phys. Lett. 98, 091106 (2011).
- [17] R. Kohler, A. Tredicucci, F. Beltram, H. E.Beere, E. H. Linfield, A. G. Davies, D. A. Ritchie,R. C. Iotti, and F. Rossi, Nature 417, 156 (2002).
- [18] K. Kawase, M. Sato, T. Taniuchi, and H. Ito, Appl. Phys. Lett. 68, 2453 (1996).
- [19] fir.u-fukui.ac.jp/
- [20] clio.lcp.u-psud.fr/clio_eng/clio_eng.htm
- [21] www.ru.nl/felix/
- [22] www.jlab.org/
- [23] www.hzdr.de/db/Cms?pNid=471
- [24] www.rs.noda.tus.ac.jp/fel-tus/
- [25] www.iae.kyoto-u.ac.jp/quantum/
- [26] www.sanken.osaka-u.ac.jp/
- [27] sbfel3.ucsb.edu/
- [28] 本田洋介他,第12回日本加速器学会年会ア ブストラクト WEP022.[www.pasj.jp/web publish/

pasj2015/abstracts/html/WEP022.htm]

- [29] A. Irizawa, private communication.
- [30] 島田美帆, OHO'08 テキスト No. 5. [accwww2.kek.jp/oho/OHOtxt3.html]

- [31] K. Ishi, Y. Shibata, T. Takahashi, H. Mishiro, T. Ohsaka, M. Ikezawa, Y. Kondo, T. Nakazato, S. Urasawa, N. Niimura, R. Kato, Y. Shibasaki, and M. Oyamada, Phys. Rev. A 43, 5597 (1991).
- [32] J. Yarwood, T. Shuttleworth, J. B. Hasted, and T. Nanba, Nature **312**, 742 (1984).
- [33] Y. Shibata, K. Ishi, T. Ohsaka, H. Mishiro, T. Takahashi, M. Ikezawa, Y. Kondo, T. Nakazato, M. Oyamada, N. Niimura, S. Urasawa, R. Kato, and Y. Torizuka, Nucl. Instrum. Meth. Sci. Res. A 301, 161 (1991).
- [34] Y. Shibata, K. Ishi, T. Takahashi, F. Arai, M. Ikezawa, K. Takami, T. Matsuyama, K. Kobayashi, and Y. Fujita, Phys. Rev. A 44, R3449 (1991).
- [35]T. Takahashi, T. Kanai, Y. Shibata, K. Ishi, M. Ikezawa, T. Nakazato, M. Oyamada, S. Urasawa, T. Yamakawa, K. Takami, T. Matsuyama, K. Kobayashi, and Y. Fujita, Phys. Rev. E 50, 4041 (1994).
- [36]K. Ishi, Y. Shibata, T. Takahashi, S. Hasebe, M. Ikezawa, K. Takami, T. Matsuyama, K. Kobayashi, and Y. Fujita, Phys. Rev. E 51, R5212 (1995).
- [37]Y. Shibata, S. Hasebe, K. Ishi, T. Takahashi, T. Ohsaka, M. Ikezawa, T. Nakazato, M. Oyamada, S. Urasawa, T. Yamakawa, and Y. Kondo, Phys. Rev. E 52, 6787 (1995).
- [38]Y. Takashima, M. Katoh, M. Hosaka, A. Mochihashi, S. Kimura, and T. Takahashi, Jpn. J. Appl. Phys. 44, L1131 (2005).
- [39] R. W. Schoenlein, S. Chattopadhyay, H. H. W. Chong, T. E. Glover, P. A. Heimann, C. V. Shank, A. A. Zholents, and M. S. Zolotorev, Science 287, 2237 (2000).
- [40]M. Abo-Bakr, J. Feikes, K. Holldack, P. Kuske, W. B. Peatman, U. Schade, G. Wüstefeld, and H.-W. Hübers, Phys. Rev. Lett. 90, 094801 (2003).

- [41] M. Ortolani, S. Lupi, L. Baldassarre, U. Schade, P. Calvani, Y. Takano, M. Nagao, T. Takenouchi, and H. Kawarada, Phys. Rev. Lett. 97, 097002 (2006)
- [42] Y. Honda, private communication.
- [43] J. D. Jackson, "Classical Electrodynamics, third edition", Wiley 1998.
- [44] M. J. Nasse, M. J. Walsh, E. C. Mattson, R. Reininger, A. Kajdacsy-Balla, V. Macias, R. Bhargava and C. J. Hirschmugl, Nature Methods 8, 413 (2011).
- [45] R. López-Delgado and H. Swarc, Opt. Commun. 19, 286 (1976).
- [46] 木村真一, J. Vac. Soc. Jpn. 53, 399 (2010).
- [47] S. Kimura, H. Kimura, T. Takahashi, K. Fukui, Y. Kondo, Y. Yoshimatsu, T. Moriwaki, T. Nanba and T. Ishikawa, Nucl. Instrum. Meth. A 467-468, 437 (2001).
- [48] S. Kimura, E. Nakamura, T. Nishi, Y. Sakurai, K. Hayashi, J. Yamazaki and M. Katoh, Infrared Phys. Tech. 49, 147 (2006).
- [49] http://science.energy.gov/~/media/bes/pdf/ reports/files/thz_rpt.pdf